



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 10-2003-0042561
Application Number

출 원 년 월 일 : 2003년 06월 27일
Date of Application JUN 27, 2003

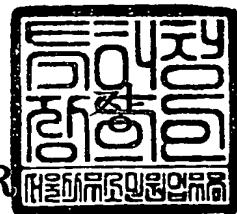
출 원 인 : 주식회사 하이닉스반도체
Applicant(s) Hynix Semiconductor Inc.



2003 년 10 월 06 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서	
【권리구분】	특허	
【수신처】	특허청장	
【참조번호】	0006	
【제출일자】	2003.06.27	
【국제특허분류】	H01L	
【발명의 명칭】	포토레지스트 종합체 및 이를 포함하는 포토레지스트 조성을 Photoresist Polymer and Photoresist Composition Containing it	
【발명의 영문명칭】		
【출원인】		
【명칭】	주식회사 하이닉스반도체	
【출원인코드】	1-1998-004569-8	
【대리인】		
【성명】	황의인	
【대리인코드】	9-1998-000660-7	
【포괄위임등록번호】	2003-017010-4	
【대리인】		
【성명】	이정훈	
【대리인코드】	9-1998-000350-5	
【포괄위임등록번호】	2003-017011-1	
【발명자】		
【성명의 국문표기】	이근수	
【성명의 영문표기】	LEE, Geun Su	
【주민등록번호】	620124-1094217	
【우편번호】	449-905	
【주소】	경기도 용인시 기흥읍 상갈리 454 주공그린빌 502동 1302호	
【국적】	KR	
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대리인 황의인 (인) 대리인 이정훈 (인)	
【수수료】		
【기본출원료】	20	면 29,000 원
【가산출원료】	6	면 6,000 원

1020030042561

출력 일자: 2003/10/14

【우선권주장료】	0 건	0 원
【심사청구료】	0 항	0 원
【합계】	35,000 원	
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통 -.	



1020030042561

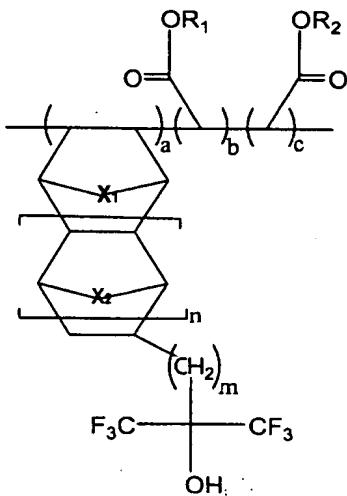
출력 일자: 2003/10/14

【요약서】

【요약】

본 발명은 포토레지스트 중합체 및 포토레지스트 조성물에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 포토레지스트 중합체 및 이 중합체를 함유하는 본 발명의 포토레지스트 조성물은 에칭 내성, 내열성 및 접착성이 우수할 뿐만 아니라, 현상액에 대한 친화도가 높기 때문에, LER(line edge roughness)를 개선시킬 수 있다.

[화학식 1]



상기 식에서,

X₁, X₂, R₁, R₂, m, n, a, b 및 c는 명세서에 정의한 바와 같다.

【대표도】

도 1

【명세서】**【발명의 명칭】**

포토레지스트 중합체 및 이를 포함하는 포토레지스트 조성물{Photoresist Polymer and Photoresist Composition Containing it}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 실시예 7에 의해 형성된 L/S 패턴 사진.

도 2는 실시예 8에 의해 형성된 콘택홀 패턴 사진.

【발명의 상세한 설명】**【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

<3> 본 발명은 포토레지스트 중합체 및 포토레지스트 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고집적 반도체 소자의 미세회로 제조 시 원자외선 영역의 광원, 특히 193nm 및 157nm 광원을 이용한 포토레지스트 공정에 사용하여, 소자의 라인 에지 러프니스(Line edge roughness : 이하, 'LER'이라 칭함)를 개선시킬 수 있는 포토레지스트 중합체 및 그 중합체를 포함하는 포토레지스트 조성물에 관한 것이다.

<4> ArF 및 VUV(vacuum ultraviolet)용 포토레지스트로 이용되기 위해서는 193nm 및 157nm 파장에서 광 흡수도가 낮아야 하고, 예칭 내성과 기판에 대한 접착성이 우수하여야 하며, 2.38wt% 및 2.6wt%의 테트라메틸암모늄히드록사이드(TMAH) 수용액으로 현상이 가능해야 하는 등의 많은 요건을 충족시켜야 한다.

- <5> 현재까지의 주된 연구 방향은 248nm 및 193nm에서 높은 투명성이 있으면서, 에칭 내성이 노블락 수지와 같은 수준의 수지를 탐색하는 것이다.
- <6> 그러나 대부분의 이들 레지스트들은 소자의 회로가 점점 미세화 되면서 레지스트 두께도 낮아지고, 그에 따라 패턴의 LER를 개선하는 것이 큰 문제점으로 대두되고 있다.
- <7> 상기 LER은 기존의 KrF나 I-line 레지스트 패턴보다 ArF용 레지스트 패턴에서 더 심하게 발생되는데, 그 이유는 종래 KrF나 I-line 레지스트의 경우 레지스트 내부에 산성의 알코올 그룹을 포함하고 있는 반면, 대부분의 ArF 레지스트는 내부에 산성의 알코올 화합물을 포함하고 있지 않기 때문에, 염기성 현상액에 대해 낮은 친화도를 가져 더 심하게 발생된다.
- <8> 이러한 현상은 화학 증폭형 레지스트를 이용한 패턴 형성 공정의 경우 발생하는 불가결한 사항으로, 후속 공정 수행 시에 반도체 소자의 안정성 및 수율 특성을 저해시킴으로 공정의 안정화가 낮아진다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

- <9> 이에 본 발명자들은 LER이 개선된 패턴을 얻기 위하여 현상액에 대한 친화도가 높은 포토레지스트용 중합체 및 상기 중합체를 함유한 포토레지스트 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

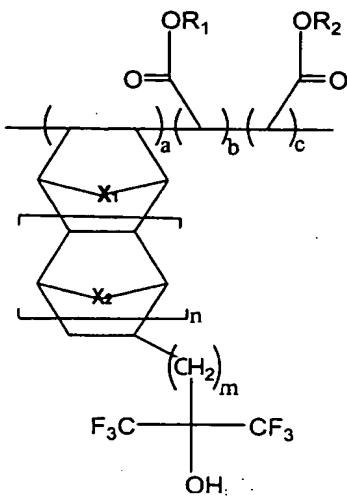
【발명의 구성 및 작용】

- <10> 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에서는 산성인 알코올 그룹을 포함하는 중합체, 상기 중합체를 포함하는 조성물 및 이를 이용한 포토레지스트 패턴 형성 방법을 제공한다.
- <11> 이하 본 발명을 상세히 설명한다.

<12> 본 발명에서는 우선, 하기 화학식 1로 표시되는 중합반복단위를 포함하는 포토레지스트 중합체를 제공한다.

<13> [화학식 1]

<14>



<15> 상기 식에서,

<16> X₁ 및 X₂는 각각 CH₂, CH₂OH, O 또는 S이고,

<17> R₁은 산에 민감한 보호기(acid labile protecting group)이고,

<18> R₂는 H, C₁~C₂₀의 알킬, C₅~C₁₀의 사이클로알킬 또는 에테르기 또는 에스테르기를 고리

내에 포함하는 C₅~C₁₀의 사이클로알킬이며,

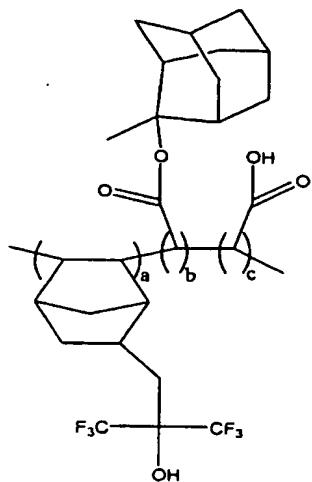
<19> m은 0 내지 2의 정수이고, n은 0 또는 1이며,

<20> a : b : c는 50mol% : 20~50mol% : 0~30mol%이다.

<21> 이때, 본 발명의 중합체는 산성의 알코올 그룹을 포함하고 있으므로, 염기성 현상액에 대해 높은 친화도를 가지고, 더하여 중합체 내에 불소 원자를 포함하므로, 기존의 하이브리드(hybrid) 형태 감광제의 문제점인 흡수도를 개선시킬 수 있다.

- <22> 상기 산에 민감한 보호기란 산에 의해 탈리 될 수 있는 그룹으로서, PR 물질의 알칼리 현상액에 대한 용해 여부를 결정한다. 즉, 산에 민감한 보호기가 붙어있는 경우에는 PR 물질이 알칼리 현상액에 의해 용해되는 것이 억제되며, 노광에 의해 발생된 산에 의해 산에 민감한 보호기가 탈리되면 PR 물질이 현상액에 용해될 수 있게 된다. 이러한 산에 민감한 보호기는 상기와 같은 역할을 수행할 수 있는 것이면 무엇이든 가능하며, 그 예로는 US 5,212,043 (1993. 5. 18), WO 97/33198 (1997. 9. 12), WO 96/37526 (1996. 11. 28), EP 0 794 458 (1997. 9. 10) EP 0 789 278 (1997. 8. 13), US 5,750,680 (1998. 5. 12), US 6,051,678 (2000. 4. 18), GB 2,345,286 A (2000. 7. 5), US 6,132,926 (2000. 10. 17), US 6,143,463 (2000. 11. 7), US 6,150,069 (2000. 11. 21), US 6,180,316 B1 (2001. 1. 30), US 6,225,020 B1 (2001. 5. 1), US 6,235,448 B1 (2001. 5. 22) 및 US 6,235,447 B1 (2001. 5. 22) 등에 개시된 것을 포함하고, 바람직하게는 *t*-부틸, 테트라하이드로피란-2-일, 2-메틸 테트라하이드로피란-2-일, 테트라하이드로퓨란-2-일, 2-메틸 테트라하이드로퓨란-2-일, 1-메톡시프로필, 1-메톡시-1-메틸에틸, 1-에톡시프로필, 1-에톡시-1-메틸에틸, 1-메톡시에틸, 1-에톡시에틸, *t*-부톡시에틸, 1-이소부톡시에틸 또는 2-아세틸멘트-1-일 등을 사용할 수 있다.
- <23> 상기 화학식 1의 중합반복단위는 하기 화학식 2 또는 하기 화학식 3인 것이 바람직하다.
- <24> [화학식 2]

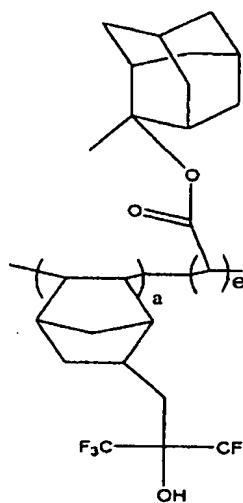
<25>



<26>

[화학식 3]

<27>



<28>

상기 화학식 2 및 3에서

<29>

a : b : c는 50mol% : 20~50mol% : 0~30mol%이고,

<30>

a : e는 50mol% : 50mol%이다.

<31>

또한, 본 발명에서는

<32>

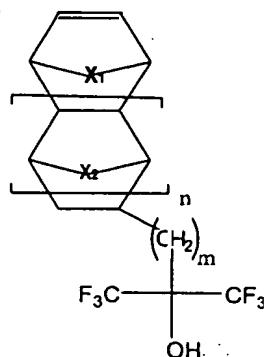
(a) 하기 화학식 7의 화합물과 말레이익안하이드라이드를 중합개시제의 존재하에서 중합시

켜 하기 화학식 4의 중합체를 얻는 단계;

- <33> (b) 하기 화학식 4의 중합체를 알코올 또는 알콕사이드 화합물과 반응시켜 중합체 내의
말레인안하이드라이드를 개환시켜 하기 화학식 5의 중합체를 제조하는 단계; 및
<34> (c) 하기 화학식 5의 중합체의 카르복실기의 일부 또는 전부를 에스테르화 또는 아세탈
화하여 상기 화학식 1의 중합체를 얻는 단계를 포함하는 포토레지스트 중합체의 제조방법을 제
공한다.

<35> [화학식 7]

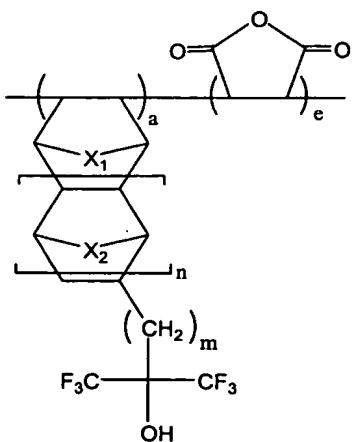
<36>



<37>

[화학식 4]

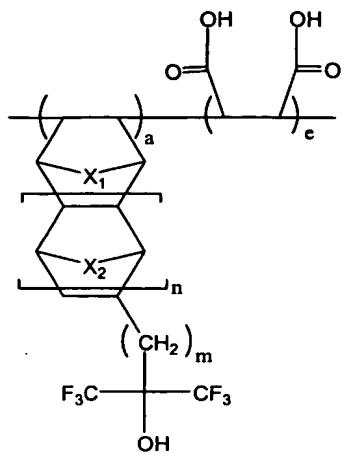
<38>



<39>

[화학식 5]

<40>



<41>

상기 화학식들에서,

<42>

X_1 및 X_2 는 각각 CH_2 , CH_2OH , O 또는 S 이고,

<43>

m 은 0 내지 2의 정수이고, n 은 0 또는 1이며,

<44>

$a : e$ 는 50mol% : 50mol% 이다.

<45>

상기 중합 반응은 라디칼 중합으로 벌크중합 또는 용액중합 등으로 수행되며, WO

96/37526 (1996.11.28)에 개시된 바와 같이 금속 촉매를 사용하여 형성할 수도 있다.

<46>

상기 (a) 단계의 중합용매는 사이클로헥사논, 사이클로펜타논, 테트라하이드로퓨란, 디메틸포름아미드, 디메틸설폭사이드, 디옥산, 메틸에틸케톤, 벤젠, 톨루엔 및 자일렌으로 이루 어진 군으로부터 선택된 단독용매 또는 혼합용매를 사용한다.

<47>

또한, 상기 (a) 단계의 중합개시제는 벤조일페온사이드, 2,2'-아조비스이소부티로니트릴 (AIBN), 아세틸페온사이드, 라우릴페온사이드, t-부틸페온테이트, t-부틸하이드로페온사이드 및 디-t-부틸페온사이드로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 사용하는 것이 바람직하다.

- <48> 상기 방법으로 제조된 중합체는 디에틸에테르, 석유에테르(petroleum ether), 메탄올, 에탄올 또는 이소프로판을 포함하는 저급 알코올 또는 물등의 단독 또는 혼합 용매로 결정 정제하는 것이 바람직하다.
- <49> 또한, 상기 (c) 단계는 상기 화학식 5의 화합물을 보호기를 갖는 화합물과 반응시켜 화학식 5의 화합물의 카르복실기를 부분적으로 보호시키는 반응인데, 이 때 보호기를 갖는 화합물은 C₁~C₂₀의 알킬, C₅~C₁₀의 사이클로알킬 또는 에테르기 또는 에스테르기를 고리내에 포함하는 C₅~C₁₀의 사이클로알킬을 포함하는 것이 바람직하다.
- <50> 본 발명에서는 또한 상기 화학식 1의 포토레지스트 중합체와, 광산발생제 및 유기용매를 포함하는 포토레지스트 조성물을 제공한다.
- <51> 상기 광산발생제는 빛에 의해 산을 발생할 수 있는 화합물이면 무엇이든 사용가능하며, US 5,212,043 (1993. 5. 18), WO 97/33198 (1997. 9. 12), WO 96/37526 (1996. 11. 28), EP 0 794 458 (1997. 9. 10) EP 0 789 278 (1997. 8. 13), US 5,750,680 (1998. 5. 12), US 6,051,678 (2000. 4. 18), GB 2,345,286 A (2000. 7. 5), US 6,132,926 (2000. 10. 17), US 6,143,463 (2000. 11. 7), US 6,150,069 (2000. 11. 21), US 6,180,316 B1 (2001. 1. 30), US 6,225,020 B1 (2001. 5. 1), US 6,235,448 B1 (2001. 5. 22) 및 US 6,235,447 B1 (2001. 5. 22) 등에 개시된 것을 포함하고, 주로 황화염계 또는 오니움염계 화합물을 사용한다. 특히, 157nm 및 193nm에서 흡광도가 적은 프탈이미도트리플루오로메탄술포네이트(phthalimidotrifluoromethane sulfonate), 디니트로벤질토실레이트(dinitrobenzyltosylate), n-데실디솔폰(n-decyl disulfone) 및 나프틸이미도트리플루오로메탄술포네이트(naphthylimido trifluoromethane sulfonate)로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 사용하는 것이 바람직하고,

이와 함께, 디페닐요도염 헥사플루오로포스페이트, 디페닐요도염 헥사플루오로 아르세네이트, 디페닐요도염 헥사플루오로 안티모네이트, 디페닐파라메톡시페닐설포늄 트리플레이트, 디페닐파라톨루에닐설포늄 트리플레이트, 디페닐파라이소부틸페닐설포늄 트리플레이트, 트리페닐설포늄 헥사플루오로 아르세네이트, 트리페닐설포늄 헥사플루오로 안티모네이트, 트리페닐설포늄 트리플레이트 및 디부틸나프틸설포늄 트리플레이트로 이루어진 군으로부터 선택된 광산발생제를 겸용할 수 있으며, 상기 포토레지스트 중합체에 대해 0.05 내지 10wt%의 비율로 사용되는 것이 바람직하다. 광산발생제가 0.05wt% 이하의 양으로 사용될 때에는 포토레지스트의 광에 대한 민감도가 취약하게 되고 10wt% 이상 사용될 때에는 광산발생제가 원자외선을 많이 흡수하고 산이 다량 발생되어 단면이 좋지 않은 패턴을 얻게 된다.

<52> 또한, 상기 유기용매는 무엇이든 사용가능하며, US 5,212,043 (1993. 5. 18), WO 97/33198 (1997. 9. 12), WO 96/37526 (1996. 11. 28), EP 0 794 458 (1997. 9. 10) EP 0 789 278 (1997. 8. 13), US 5,750,680 (1998. 5. 12), US 6,051,678 (2000. 4. 18), GB 2,345,286 A (2000. 7. 5), US 6,132,926 (2000. 10. 17), US 6,143,463 (2000. 11. 7), US 6,150,069 (2000. 11. 21), US 6,180,316 B1 (2001. 1. 30), US 6,225,020 B1 (2001. 5. 1), US 6,235,448 B1 (2001. 5. 22) 및 US 6,235,447 B1 (2001. 5. 22) 등에 개시된 것을 포함하고, 바람직하게는 디에틸렌글리콜디에틸에테르 (diethylene glycol diethyl ether), 메틸 3-메톡시프로피오네이트, 에틸 3-에톡시프로피오네이트, 프로필렌글리콜 메틸에테르아세테이트, 사이클로헥사논 또는 2-헵타논 등을 단독으로 또는 혼합하여 사용할 수 있으며, 상기 포토레지스트 중합체에 대해 500 내지 2000wt% 비율로 사용되는데, 이는 원하는 두께의 포토레지스트 막을 얻기 위한 것인데, 예를 들면, 포토레지스트 중합체에 대해 유기용매가 1000wt% 사용될 때의 포토레지스트 두께는 약 $0.25\mu\text{m}$ 이다.

<53> 본 발명에서는 또한 하기와 같은 단계로 이루어지는 포토레지스트 패턴 형성방법을 제공 한다 :

<54> (a) 전술한 본 발명의 포토레지스트 조성물을 피식각층 상부에 도포하여 포토레지스트 막을 형성하는 단계;

<55> (b) 상기 포토레지스트 막을 노광하는 단계;

<56> (c) 상기 노광 된 포토레지스트 막을 베이크하는 단계; 및

<57> (d) 상기 결과물을 현상하여 원하는 패턴을 얻는 단계.

<58> 상기 과정에서, 노광 전에 베이크 공정을 실시하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 이러한 베이크 공정은 70 내지 200°C에서 수행된다.

<59> 상기 노광 공정은 Ar뿐만 아니라, KrF, EUV(Extreme Ultra Violet), VUV (Vacuum Ultra Violet), E-빔, X-선 또는 이온빔을 이용하고, 1 내지 100mJ/cm²의 노광에너지로 수행되는 것 이 바람직하다.

<60> 한편, 상기 (d) 단계의 현상은 알칼리 현상액, 예를 들면 0.01 내지 5wt%의 TMAH 수용액 을 이용하여 수행하는 것이 바람직하다.

<61> 본 발명에서는 또한 전술한 패턴 형성방법을 이용하여 제조된 반도체 소자를 제공한다.

<62> 이하 본 발명을 실시예에 의하여 상세히 설명한다. 단 실시예는 발명을 예시하는 것일 뿐 본 발명이 하기 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니다.

<63> I. 포토레지스트 중합체의 제조

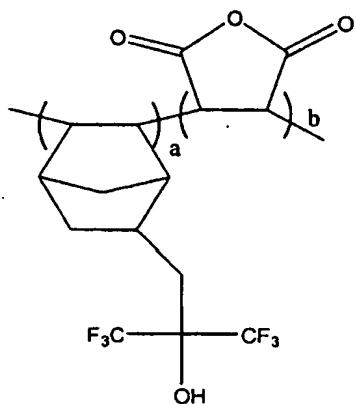
<64> 실시예 1. 화학식 2의 중합체의 합성

<65> (단계 1)

<66> 노르보넨 헥사플루오로 아이소프로필알콜(0.1M), 말레이안하이드라이드 (0.1M) 및 AIBN(0.2g)을 테트라히드로퓨란(60mL)에 녹인 후, 65°C에서 24시간 반응시켰다. 반응 후 혼합물을 간접 증류한 후, 디에틸에테르에서 폴리머를 침전, 여과하여 하기 화학식 4a의 중합체를 얻었다(수율 : 75%, M_w=6530).

<67> [화학식 4a]

<68>

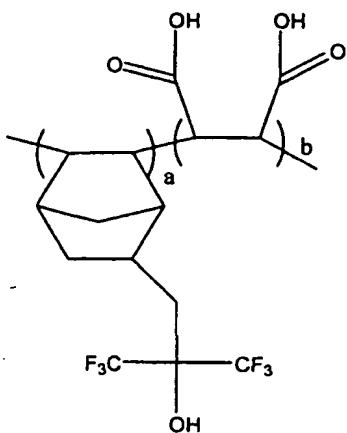


<69> (단계 2)

<70> 상기 단계 1의 중합체(20g), 황산(0.01g)을 증류수(100mL)에 혼합한 후, 100°C에서 4시간 반응시켰다. 반응 후 혼합물을 5°C로 냉각시켜 폴리머를 침전시킨 후, 500mL의 냉각수로 여과하여 산을 제거한 다음 진공 건조시켜 하기 화학식 5a의 중합체를 얻었다.

<71> [화학식 5a]

<72>



<73>

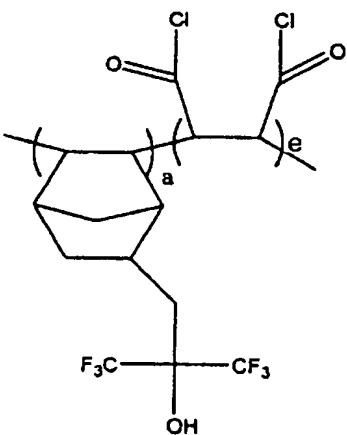
(단계 3)

<74> 상기 단계 2의 중합체(0.1M)와 티오닐클로라이드(SOCl_2)(50mL)를 혼합하여 5시간동안 환류(reflux) 시킨 후, 진공 증류한 다음 티오닐클로라이드를 제거하여 하기 화학식 6의 중합체를 얻었다(수율 : 100%).

<75>

[화학식 6]

<76>



<77>

(단계 4)

<78> 상기 단계 3의 중합체(0.1M)와 2-메틸-2-아다만타놀(0.19M)을 마그네슘 살레이트(MgSO_4)를 이용하여 탈수(dry) 시킨 메틸렌클로라이드(CH_2Cl_2)(100mL)에 녹였다. 상기 혼합물을 트리

에틸아민($N(C_2H_5)_3$)(0.11M)에 천천히 가한 후, 4시간 동안 25°C에서 반응시켰다. 반응 종료 후 혼합물을 여과한 후 중류하여 용매를 제거하였다. 상기 고체를 물/에탄올(1:1)로 세척한 후, 진공 건조하여 상기 화학식 2의 중합체를 얻었다(수율 : 95%).

<79> 실시예 2. 화학식 3의 중합체의 합성

<80> 상기 실시예 1의 단계 3에서 제조된 중합체(0.1M)와 2-메틸-2-아다만타놀(0.21M)을 마그네슘 설페이트($MgSO_4$)를 이용하여 탈수(dry) 시킨 메틸렌클로라이드(CH_2Cl_2)(100mL)에 녹였다. 상기 혼합물을 트리에틸아민 ($N(C_2H_5)_3$)(0.11M)에 천천히 가한 후, 6시간 동안 25°C에서 반응시켰다. 반응 종료 후 혼합물을 여과한 후 중류하여 용매를 제거하였다. 상기 고체를 물/에탄올(1:1)로 세척한 후, 진공 건조하여 상기 화학식 3의 중합체를 얻었다(수율 : 91%).

<81> II. 포토레지스트 조성물의 제조 및 패턴 형성

<82> 실시예 3.

<83> 상기 실시예 1의 단계 4에서 제조된 중합체(2g)와 광산발생제인 프탈이미도트리플루오로메탄슬포네이트(0.024g)와 트리페닐설포늄 트리플레이트(0.06g)를 프로필렌글리콜메틸에틸아세테이트(PGMEA)(20g)에 녹인 후 0.20 μm 필터로 여과시켜 포토레지스트 조성물을 얻었다.

<84> 이렇게 얻은 포토레지스트 조성물을 실리콘 웨이퍼의 피식각층 상부에 스판 코팅하여 포토레지스트 박막을 제조한 다음, 130°C의 오븐 또는 열판에서 90초간 소프트 베이크를 하고, ArF 레이저 노광장비로 노광한 후 130°C에서 90초간 다시 베이크 하였다. 이렇게 베이크한 웨이퍼를 2.38 mol% TMAH 수용액에서 40초간 침지하여 현상함으로써 0.08 μm 의 L/S 패턴을 형성하였다(도 1 참조).

<85> 실시예 4.

<86> 상기 실시예 1에서 제조된 중합체 대신에 실시예 2에서 제조된 중합체(2g)를 사용하는 것을 제외하고는 상기 실시예 3과 동일한 방법으로 포토레지스트 조성물을 제조하고 이 조성물을 이용하여 $0.08\mu\text{m}$ 의 콘택홀 패턴을 형성하였다(도 2 참조).

【발명의 효과】

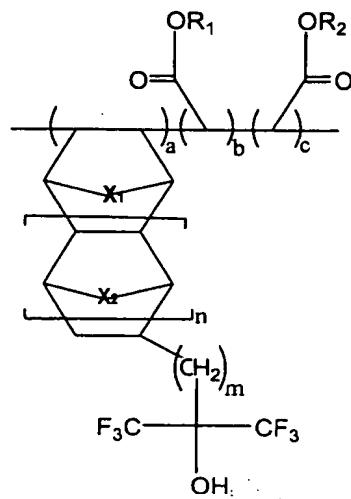
<87> 이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 포토레지스트 조성물은 산성의 알코올 그룹을 포함하고 있기 때문에, 염기성 현상액에 대한 친화도가 높아 LER이 개선된 패턴을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 불소를 포함하고 있어 193nm 뿐만 아니라, 157nm 영역에서 낮은 흡광도를 갖고, 더하여 내구성, 에칭내성, 재현성 및 해상력이 뛰어나, 1G 이하의 DRAM은 물론 4G, 16G DRAM 이상의 초미세 패턴을 형성할 수 있다.

【특허 청구범위】

【청구항 1】

하기 화학식 1로 표시되는 중합반복단위를 포함하는 포토레지스트 중합체.

[화학식 1]



상기 식에서,

X_1 및 X_2 는 각각 CH_2 , CH_2OH , O 또는 S 이고,

R_1 은 산에 민감한 보호기(acid labile protecting group)이고,

R_2 는 H , $\text{C}_1\sim\text{C}_{20}$ 의 알킬, $\text{C}_5\sim\text{C}_{10}$ 의 사이클로알킬 또는 에테르기 또는 에스테르기를 고리 내에 포함하는 $\text{C}_5\sim\text{C}_{10}$ 의 사이클로알킬이며,

m 은 0 내지 2의 정수이고, n 은 0 또는 1이며,

$a : b : c$ 는 50mol% : 20~50mol% : 0~30mol%이다.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

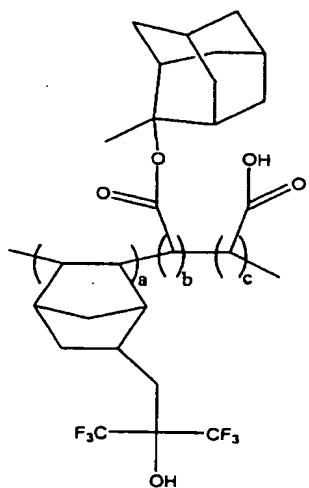
상기 산에 민감한 보호기는 *t*-부틸, 테트라하이드로피란-2-일, 2-메틸 테트라하이드로피란-2-일, 테트라하이드로퓨란-2-일, 2-메틸 테트라하이드로퓨란-2-일, 1-메톡시프로필, 1-메톡시-1-메틸에틸, 1-에톡시프로필, 1-에톡시-1-메틸에틸, 1-메톡시에틸, 1-에톡시에틸, *t*-부톡시에틸, 1-이소부톡시에틸 및 2-아세틸멘트-1-일로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 등을 특징으로 하는 포토레지스트 중합체.

【청구항 3】

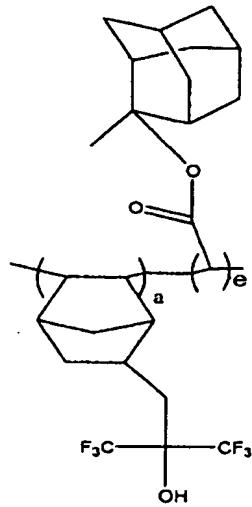
제 1 항에 있어서,

상기 중합체는 하기 화학식 2의 또는 화학식 3의 중합반복단위를 포함하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 중합체.

[화학식 2]



[화학식 3]



상기 화학식 2 및 3에서

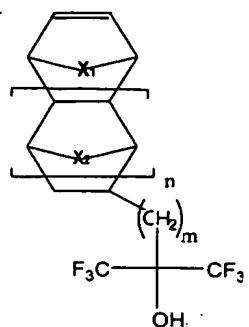
a : b : c 는 50 mol% : 20~50mol% : 0~30mol%이고,

a: e는 50 mol% : 50mol%이다.

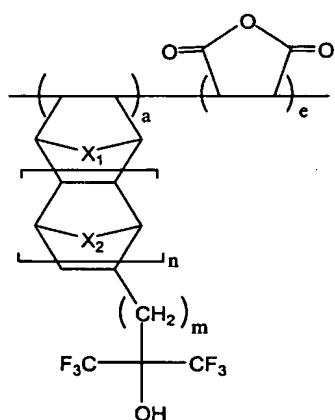
【청구항 4】

- (a) 하기 화학식 7의 화합물과 말레이익안하이드라이드를 중합개시제의 존재하에서 중합시켜 하기 화학식 4의 중합체를 얻는 단계;
- (b) 하기 화학식 4의 중합체를 알코올 또는 알콕사이드 화합물과 반응시켜 중합체 내의 말레이익안하이드라이드를 개환시켜 하기 화학식 5의 중합체를 제조하는 단계; 및
- (c) 하기 화학식 5의 중합체의 카르복실기의 일부 또는 전부를 에스테르화 또는 아세탈화하여 상기 화학식 1의 중합체를 얻는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 중합체의 제조방법.

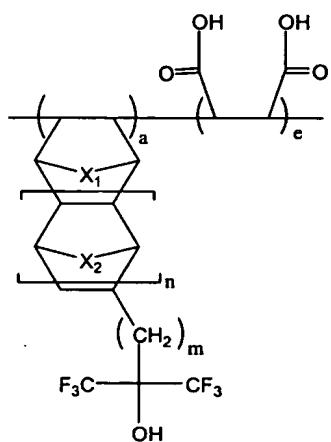
[화학식 7]



[화학식 4]



[화학식 5]



상기 화학식들에서,



1020030042561

출력 일자: 2003/10/14

X_1 및 X_2 는 각각 CH_2 , CH_2OH , 0 또는 S이고,

m은 0 내지 2의 정수이고, n은 0 또는 1이며,

a : e는 50mol% : 50mol% 이다.

【청구항 5】

제 4 항에 있어서,

상기 (a) 단계의 중합은 사이클로헥사논, 사이클로펜타논, 테트라하이드로퓨란, 디메틸포름아미드, 디메틸설폐사이드, 디옥산, 메틸에틸케톤, 벤젠, 툴루엔 및 자일렌으로 이루어진 군으로부터 선택된 단독용매 또는 혼합용매를 사용하는 용액 중합인 것을 특징으로 하는 포토레지스트 중합체의 제조방법.

【청구항 6】

제 4 항에 있어서,

상기 (a) 단계의 중합개시제는 벤조일페옥사이드, 2,2'-아조비스이소부티로니트릴 (AIBN), 아세틸페옥사이드, 라우릴페옥사이드, t-부틸페아세테이트, t-부틸하이드로페옥사이드 및 디-t-부틸페옥사이드로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 사용하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 중합체의 제조방법.

【청구항 7】

제 4 항에 있어서,

상기 (a) 단계에서 얻어진 중합체를 디에틸에테르, 석유에테르 (petroleum ether), 메탄올, 에탄올 또는 이소프로판을 포함하는 저급 알코올 및 물로 이루어진 군으로부터 선택된 단독 또는 혼합 용매를 이용하여 결정 정제하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 8】

제 1 항 기재의 포토레지스트 중합체와, 광산발생제 및 유기용매를 포함하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 9】

제 8 항에 있어서,

상기 광산발생제는 프탈이미도트리플루오로메탄술포네이트(phthalimidotrifluoromethane sulfonate), 디니트로벤질토실레이트(dinitrobenzyltosylate), n-데실디솔폰(n-decyl disulfone) 및 나프틸이미도트리플루오로메탄술포네이트(naphthylimido trifluoromethane sulfonate)로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 10】

제 8 항에 있어서,

상기 광산발생제에 더하여 디페닐요도염 헥사플루오로포스페이트, 디페닐요도염 헥사플루오로 아르세네이트, 디페닐요도염 헥사플루오로 안티모네이트, 디페닐파라메톡시페닐설포늄 트리플레이트, 디페닐파라톨루에닐설포늄 트리플레이트, 디페닐파라이소부틸페닐설포늄 트리플레이트, 트리페닐설포늄 헥사플루오로 아르세네이트, 트리페닐설포늄 헥사플루오로 안티모네이트, 트리페닐설포늄 트리플레이트 및 디부틸나프틸설포늄 트리플레이트로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 함께 사용하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.



1020030042561

출력 일자: 2003/10/14

【청구항 11】

제 8 항에 있어서,

광산발생제는 포토레지스트용 중합체에 대해 0.05 내지 10wt% 비율로 사용되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 12】

제 8 항에 있어서,

상기 유기용매는 에틸 3-에톡시프로피오네이트(ethyl 3-ethoxypropionate), 메틸 3-메톡시 프로피오네이트(methyl 3-methoxypropionate), 사이클로헥사논 (cyclohexanon), 프로필렌글리콜 메틸에테르아세테이트, n-헵타논 (n-heptanone) 및 에틸 락테이트로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 13】

제 8 항에 있어서,

상기 유기용매는 상기 포토레지스트용 중합체에 대해 500 내지 2000wt% 비율로 사용되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 조성물.

【청구항 14】

(a) 제 8 항 기재의 포토레지스트 조성을 피식각층 상부에 도포하여 포토레지스트 막을 형성하는 단계;

(b) 상기 포토레지스트 막을 노광하는 단계;



1020030042561

출력 일자: 2003/10/14

- (c) 상기 노광된 포토레지스트 막을 베이크하는 단계; 및
- (d) 상기 결과물을 현상하여 원하는 패턴을 얻는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 15】

제 14 항에 있어서,

상기 (b) 단계의 노광 전에 베이크 공정을 실시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 16】

제 14항 또는 15 항에 있어서,

상기 베이크 공정은 70 내지 200°C에서 수행되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 17】

제 14 항에 있어서,

상기 노광 공정은 ArF, KrF 및 EUV (Extreme Ultra Violet), VUV (Vacuum Ultra Violet), E-빔, X-선 또는 이온 빔을 이용하여 수행하는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 18】

제 14 항에 있어서,

상기 노광공정은 0.1 내지 100mJ/cm²의 노광에너지로 수행되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 19】

제 14 항에 있어서,

상기 (d) 단계의 현상은 알칼리 현상액을 이용하여 수행되는 것을 특징으로 하는 포토레지스트 패턴 형성방법.

【청구항 20】

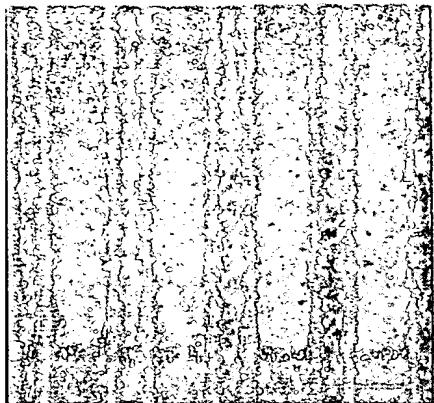
제 14 항 기재의 방법에 의해 제조된 반도체 소자.

1020030042561

출력 일자: 2003/10/14

【도면】

【도 1】



【도 2】

